Antenas y Circuitos de Alta Frecuencia (ACAF) Primera parte, Tema II

Profesores: Jorge A. Ruiz Cruz (jorge.ruizcruz@uam.es)
José L. Masa Campos (joseluis.masa@uam.es)

Colaboradores de este tema: José R. Montejo (*) y Jesús M. Rebollar (*)

(*) Dpto. de Electromagnetismo y Teoría de Circuitos Universidad Politécnica de Madrid





Master en Ingeniería Informática y de Telecomunicación Escuela Politécnica Superior Universidad Autónoma de Madrid



Primera parte de ACAF: Circuitos de Alta Frecuencia.



I. PROCESADO DE SEÑAL EN RF.



II. TEORÍA CIRCUITAL DE LOS DISPOSITIVOS DE RF.

III. DISEÑO DE CIRCUITOS PASIVOS DE RF.

IV. DISPOSITIVOS EN GUÍA DE ONDA.

Antenas y Circuitos de Alta Frecuencia, www.eps.uam.es/~acaf Master en Ingeniería Informática y de Telecomunicación Escuela Politécnica Superior, Universidad Autónoma de Madrid Jorge A. Ruiz Cruz (jorge.ruizcruz@uam.es, www.eps.uam.es/~jruiz)

ACAF (2007-08)

ver. 0



II. Teoría circuital de los dispositivos de RF

- 1. Ondas de potencia y parámetros S.
- 2. Diagrama de flujo con parámetros S.
- 3. Propiedades de la matriz S: reciprocidad, unitariedad, simetría.
- 4. Medida de parámetros S. Calibración.
- 5. Desplazamiento de los planos de referencia.
- 6. Cambio de la impedancia de referencia.
- 7. Conexión en cascada de dos cuadripolos con parámetros S.
- 8. Teorema de Bartlett: simetría de los dispositivos pasivos.
- Relación entre parámetros S, Z, Y, ABCD.
- 10. Cálculo de los parámetros S de circuitos concentrados y distribuidos.
- 11. Análisis por ordenador de dispositivos caracterizados por matriz S.
- 12. Dispositivos de 2, 3 y 4 puertas.

ACAF (2007-08)

Antenas y Circuitos de Alta Frecuencia. Parte I

3

ver. 0

J.R.M.G, J.A.R.C

1. Ondas de potencia y parámetros S



> Justificación:

- A las frecuencias de microondas, la medida de tensiones y corrientes es un tarea complicada. Incluso, bajo ciertas circunstancias puede que no exista unicidad en la definición de dichas magnitudes.
- Por ejemplo, en el caso de modos TE y TM en una guía de onda, no existe una definición única de tensión y corriente cuyo significado físico sea el mismo que el asociado a un modo TEM.
- En general, tensiones y corrientes juegan un papel secundario, reservándose el papel principal a la potencia, que es más sencilla de caracterizar y medir.

1. Ondas de potencia y parámetros S



> Justificación (cont):

- Por otro lado, sería de gran interés poder utilizar los conceptos de baja frecuencia, como impedancia, admitancia, tensión, corriente, etc., donde existe una teoría circuital bien establecida.
- La caracterización mediante parámetros Z, Y ó ABCD impone en las puertas condiciones de circuito abierto o de cortocircuito. Estás condiciones no son operativas en los dispositivos de microondas, porque pueden conducir a la destrucción del dispositivo o a generar radiación.
- Además, existen diversos circuitos que no se pueden caracterizar mediante los parámetros Z, Y ó ABCD porque se hacen singulares, como por ejemplo el transformador ideal.
- Todas estas consideraciones obligan a la definición de los parámetros S (Scattering) o de dispersión ó distribución, para caracterizar los dispositivos de microondas.

ACAF (2007-08)

II. Teoría Circuital de los dispositivos de RF.

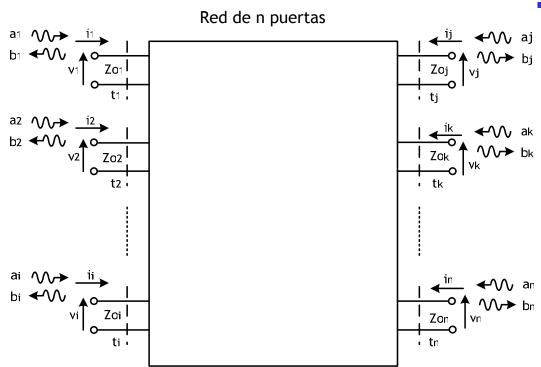
ve

ver. 0

J.R.M.G, J.A.R.C

1. Ondas de potencia y parámetros S





ACAF (2007-08)

II. Teoría Circuital de los dispositivos de RF.

)

ver. 0

Ondas de potencia y parámetros S



Ondas de potencia generalizadas

$$a_i = \frac{v_i + Z_{0i} \, i_i}{\sqrt{8 \, \text{Re}[Z_{0i}]}} \qquad b_i = \frac{v_i - Z_{0i}^* \, i_i}{\sqrt{8 \, \text{Re}[Z_{0i}]}} \quad Z_{0i} \in C$$

- Físicamente relacionadas con el flujo de potencia en la red
- Aplicación en dispositivos activos; amplificadores, mezcladores, etc.
- Matriz S

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & \dots & S_{1n} \\ S_{21} & S_{22} & \dots & S_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ S_{n1} & S_{n2} & \dots & S_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \dots \\ a_n \end{bmatrix}$$

ACAF (2007-08)

II. Teoría Circuital de los dispositivos de RF.

ver. 0

J.R.M.G. J.A.R.C

Ondas de potencia y parámetros S



Ondas de potencia no generalizadas

$$a_i = \frac{v_i + Z_{0i} \, i_i}{\sqrt{8 Z_{0i}}} \qquad b_i = \frac{v_i - Z_{0i} \, i_i}{\sqrt{8 Z_{0i}}} \qquad Z_{0i} \in R$$

$$v_{i} = (a_{i} + b_{i})\sqrt{2Z_{0i}}$$
 $i_{i} = (a_{i} - b_{i})\sqrt{\frac{2}{Z_{0i}}}$

Matriz S

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ ... \\ b_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & ... & S_{1n} \\ S_{21} & S_{22} & ... & S_{2n} \\ ... & ... & ... & ... \\ S_{n1} & S_{n2} & ... & S_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ ... \\ a_n \end{bmatrix}$$

 Todos lo conceptos y desarrollos que siguen, se refieren a las ondas de potencia no generalizadas

1. Ondas de potencia y parámetros S



• En el plano terminal t_i de la puerta i

$$V_{i} = V_{i}^{+} + V_{i}^{-}$$
 $i_{i} = \frac{V_{i}^{+} - V_{i}^{-}}{Z_{0i}}$

• Sustituyendo

$$a_i = \frac{v_i^+}{\sqrt{2Z_{0i}}}$$
 $b_i = \frac{v_i^-}{\sqrt{2Z_{0i}}}$

• Las ondas de potencia incidente y reflejada en la puerta i son proporcionales respectivamente a las ondas de tensión incidente y reflejada en dicha puerta

ACAF (2007-08)

II. Teoría Circuital de los dispositivos de RF.

9

ver. 0

J.R.M.G, J.A.R.C

1. Ondas de potencia y parámetros S



- Puerta genérica i
- Ondas de potencia no generalizadas
 - i, corriente en la puerta i
 - v_i voltaje en la puerta i
 - a, onda de potencia incidente en puerta i
 - b, onda de potencia reflejada en puerta i
 - t, plano de referencia en puerta i
 - Z_{oi} impedancia de referencia en la puerta i $Z_{oi} \in R$

$$\frac{1}{2}\text{Re}[v_i i_i^*] = |a_i|^2 - |b_i|^2 = \text{Potencia entregada en la puerta i}$$

- ullet Z_{oi} parámetro de referencia con dimensiones de impedancia
- Los valores de tensión y corriente son de pico

Ondas de potencia y parámetros S

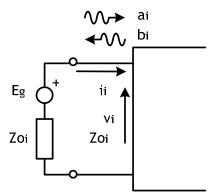


Excitación en la puerta i

$$a_{i}=\frac{v_{i}+Z_{0i}}{\sqrt{8Z_{0i}}}i_{i}$$

$$V_i = E_g - Z_{0i} i_i$$

$$a_i = \frac{E_g}{\sqrt{8Z_{0i}}}$$



$$\left|a_{i}\right|^{2} = \frac{\left|E_{g}\right|^{2}}{8Z_{0i}} = P_{dg}$$
 Potencia disponible del generador

$$\frac{1}{2}\text{Re}[v_i i_i^*] = |a_i|^2 - |b_i|^2 = \text{Potencia entregada en la puerta i}$$

ACAF (2007-08)

II. Teoría Circuital de los dispositivos de RF.

11

ver. 0

J.R.M.G. J.A.R.C

Ondas de potencia y parámetros S



- Significado físico de los parámetros S:
- Coeficientes de reflexión

$$S_{ii} = \frac{b_i}{a_i} \Big|_{a_j = 0, \quad \forall j \neq i}$$

Coeficientes de reflexión
$$\left|S_{ii}\right|^2 = \frac{\text{Potencia reflejada en la puerta i}}{\text{Potencia disponible en la puerta i}}$$

$$\left|S_{ii}\right|^2 = \frac{\text{Potencia reflejada en la puerta i}}{\text{Potencia disponible en la puerta i}}$$

$$\left|a_{j}\right| = 0, \quad \forall j \neq i$$

$$\text{Pérdidas de retorno (dB)} = -20 \log \left|S_{ii}\right|$$

$$S_{ji} = \frac{b_j}{a_i} \bigg|_{a_j = 0, \quad \forall j \neq i}$$

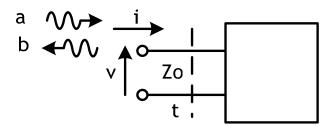
$$\left|S_{ji}\right|^2 = \frac{\text{Potencia entregada en la puerta } j}{\text{Potencia disponible en la puerta } i}$$

Pérdidas de inserción (dB) = $-20 \log |S_{ii}|$

Ondas de potencia y parámetros S



• Cálculo de los parámetros S: Monopolo



$$b = Sa$$
 $S = \rho$

$$S = \rho = \frac{b}{a} = \frac{v - Z_0 i}{v + Z_0 i} = \frac{Z_{in} - Z_0}{Z_{in} + Z_0} \qquad \qquad Z_{in} \qquad \text{Impedancia de entrada}$$

ACAF (2007-08)

II. Teoría Circuital de los dispositivos de RF.

13

ver. 0

J.R.M.G, J.A.R.C

Ondas de potencia y parámetros S



Cálculo de los parámetros S: Cuadripolo

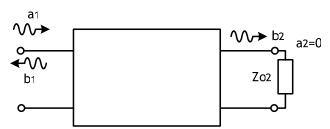
a1
$$\longleftrightarrow$$
 $i1$ \longleftrightarrow $i2$ \longleftrightarrow \longrightarrow $i2$ \longleftrightarrow $i2$ \longleftrightarrow

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$$

1. Ondas de potencia y parámetros S



• Cálculo de los parámetros S: Cuadripolo



$$S_{11} = \frac{b_1}{a_1} \Big|_{a_2 = 0}$$
 $S_{21} = \frac{b_2}{a_1} \Big|_{a_2 = 0}$ $a_2 = 0 \Leftrightarrow v_2 = -Z_{02}i_2$ Puerta 2 cargada con Z_{02}

$$S_{11} = \frac{v_1 - Z_{01}i_1}{v_1 + Z_{01}i_1} = \frac{Z_{in1} - Z_{01}}{Z_{in1} + Z_{01}} \qquad S_{21} = \sqrt{\frac{Z_{01}}{Z_{02}}} \frac{v_2 - Z_{02}i_2}{v_1 + Z_{01}i_1} = \sqrt{\frac{Z_{01}}{Z_{02}}} \frac{2v_2}{v_1 + Z_{01}i_1}$$

Z_{in1} impedancia de entrada en la puerta 1

ACAF (2007-08)

II. Teoría Circuital de los dispositivos de RF.

15

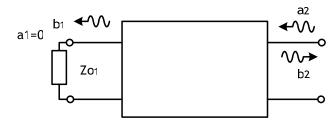
ver. 0

J.R.M.G, J.A.R.C

1. Ondas de potencia y parámetros S



• Cálculo de los parámetros S: Cuadripolo



$$S_{12} = \frac{b_1}{a_2} \Big|_{a_1 = 0}$$
 $S_{22} = \frac{b_2}{a_2} \Big|_{a_1 = 0}$ $a_1 = 0 \Leftrightarrow v_1 = -Z_{01}i_1$ Puerta 1 cargada con Z_{01}

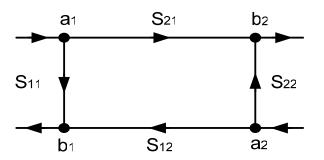
$$S_{12} = \frac{v_1 - Z_{01} i_1}{v_2 + Z_{02} i_2} = \sqrt{\frac{Z_{02}}{Z_{01}}} \frac{2 v_1}{v_2 + Z_{02} i_2} \qquad S_{22} = \frac{v_2 - Z_{02} i_2}{v_2 + Z_{02} i_2} = \frac{Z_{in2} - Z_{02}}{Z_{in2} + Z_{02}}$$

 Z_{in2} impedancia de entrada en la puerta 2

2. Diagrama de flujo con parámetros S



- Un diagrama de flujo es una herramienta que permite expresar relaciones circuitales de forma sencilla
- Es de gran aplicación en el caso de parámetros S porque simplifica los cálculos
- Cada variable (a, independientes, b, dependientes) es un nodo.
- Cada constante $(S_{11}, S_{12}, S_{21}, S_{22})$ es una rama que va de uno nodo independiente a otro dependiente.



$$\begin{aligned} b_1 &= S_{11} a_1 + S_{12} a_2 \\ b_2 &= S_{21} a_1 + S_{22} a_2 \end{aligned}$$

ACAF (2007-08)

II. Teoría Circuital de los dispositivos de RF.

17

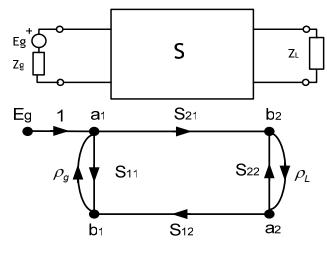
ver. 0

J.R.M.G, J.A.R.C

2. Diagrama de flujo con parámetros S



• Calculo de la respuesta de un cuadripolo



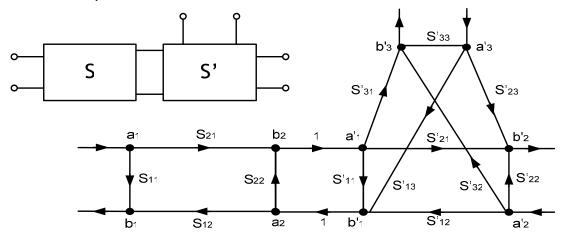
$$\frac{b_{_{2}}}{E_{_{g}}} = \frac{S_{_{21}}}{1 - S_{_{11}}\rho_{_{g}} - S_{_{22}}\rho_{_{L}} + S_{_{11}}S_{_{22}}\rho_{_{g}}\rho_{_{L}} - S_{_{12}}S_{_{21}}\rho_{_{g}}\rho_{_{L}}}$$

Simplified signal flow graph analysis. Nicholas Kuhn Hewlett-Packard. The Microwave Journal 1963

2. Diagrama de flujo con parámetros S



• Enlace de parámetros S



$$\begin{aligned} b_1 &= S_{11} a_1 + S_{12} a_2 \\ b_2 &= S_{21} a_1 + S_{22} a_2 \end{aligned}$$

$$\begin{split} b_1' &= S_{11}' a_1' + S'_{12} a_2' + S'_{13} a_3' \\ b_2' &= S_{21}' a_1' + S_{22}' a_2' + S'_{23} a_3' \\ b_3' &= S_{31}' a_1' + S_{32}' a_2' + S'_{33} a_3' \end{split}$$

ACAF (2007-08)

II. Teoría Circuital de los dispositivos de RF.

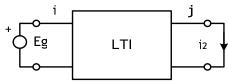
19

ver. 0

J.R.M.G, J.A.R.C

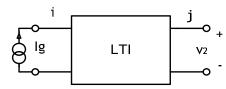
3. Propiedades de la matriz S: reciprocidad, unitariedad, simetría.





Eg LTI

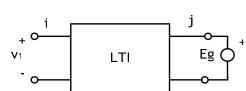
Reciprocidad



LTI

V1=V2





lg v1=Eg i2

Relaciones válidas para cualquier par de puertas i, j de una red de N puertas

ACAF (2007-08)

II. Teoría Circuital de los dispositivos de RF.

20

ver. 0



Reciprocidad

$$s_{ij} = s_{ji}$$
 $[S] = [S]_t$

- En una red de N puertas habrá $N^2 + N$ parámetros S diferentes
- grados de libertad $N^2 + N$ Y por lo tanto
- Ejemplo de una red 4 puertas recíproca

$$S = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{13} & S_{14} \\ S_{12} & S_{22} & S_{23} & S_{24} \\ S_{13} & S_{23} & S_{33} & S_{34} \\ S_{14} & S_{24} & S_{34} & S_{44} \end{bmatrix}$$

• La idea que subyace bajo la propiedad de reciprocidad es que la relación entre la repuesta y la excitación se mantiene al intercambiar éstas

ACAF (2007-08)

II. Teoría Circuital de los dispositivos de RF.

21

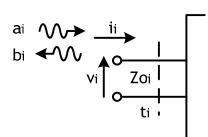
ver. 0

J.R.M.G. J.A.R.C

Propiedades de la matriz S: reciprocidad, unitariedad, simetría.



Unitariedad



Potencia entregada a la puerta i

$$\frac{1}{2} \operatorname{Re}[\boldsymbol{v}_i \boldsymbol{i}_i^*] = \left| \boldsymbol{a}_i \right|^2 - \left| \boldsymbol{b}_i \right|^2$$

Potencia total entrega a las N puertas

$$P = \sum_{i=1}^{n} \left| a_{i} \right|^{2} - \left| b_{i} \right|^{2} = [a]_{t}^{*}[a] - [b]_{t}^{*}[b] = [a]_{t}^{*}[a] - [a]_{t}^{*}[S]_{t}^{*}[S][a] = [a]_{t}^{*}([U] - [S]_{t}^{*}[S])[a]$$

$$[Q] = [U] - [S]_{t}^{*} [S]$$

 $[Q] = [U] - [S]_{+}^{*} [S]$ • [Q] es una matriz hermítica

$$[Q] = [Q]_t^x$$

$$\boldsymbol{q}_{ij} = \boldsymbol{q}_{ji}^{^{\star}}$$

Elementos de la diagonal principal reales



- Unitariedad
- En una red pasiva la potencia total entregada debe ser positiva $P = [a]_t^*[Q][a] \ge 0$

$$[Q] = [U] - [S] \stackrel{*}{,} [S]$$

•[Q] es una matriz semidefinida positiva

- La condición necesaria y suficiente para que una matriz sea semidefinida positiva es que los cofactores principales no sean negativos.
- Los elementos de la diagonal de Q son cofactores principales y tampoco pueden ser negativos.

$$q_{jj} = 1 - \sum_{i} s_{ij}^{*} s_{ij} = 1 - \sum_{i} |s_{ij}|^{2} \ge 0$$

$$|s_{ij}(jw)|^{2} \le 1$$

• En una red pasiva, los módulos de los coeficientes de reflexión y transmisión no pueden exceder la unidad.

ACAF (2007-08)

II. Teoría Circuital de los dispositivos de RF.

23

ver. 0

J.R.M.G. J.A.R.C

3. Propiedades de la matriz S: reciprocidad, unitariedad, simetría.



- Unitariedad
 - En una red pasiva y sin pérdidas la potencia total entregada es nula.

$$[Q] = [U] - [S]_t^* [S] = [0]$$

$$[S]_t^*[S] = [U] = [S][S]_t^*$$
 $[S]_t^*[S] = [U] = [S][S]_t^*$

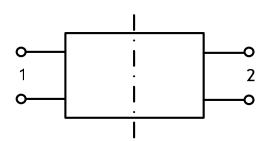
$$[S]^{-1} = [S]_t^*$$
 •[S] es una matriz unitaria

$$\sum_{i=1}^{n} \mathbf{S}_{ij}^{*} \mathbf{S}_{ik} = \delta_{jk} \quad \delta_{jk}$$
 delta de Kronecker



- Simetría
 - Red de 2 puertas
- 1 plano de simetría
- Puertas 1 y 2 indistinguibles

- Red de 3 puertas
- 1 plano de simetría
- Puertas 2 y 3 indistinguibles



$$S_{11} = S_{22}$$
 Simétrico
 $S_{11} = -S_{22}$ Antimétrico

$$S_{22} = S_{33}$$

 $S_{12} = S_{13}$
 $S_{21} = S_{31}$

ACAF (2007-08)

II. Teoría Circuital de los dispositivos de RF.

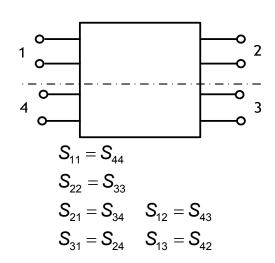
25 ver. 0

J.R.M.G, J.A.R.C

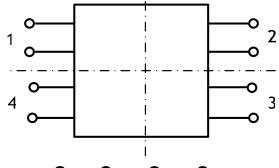
3. Propiedades de la matriz S: reciprocidad, unitariedad, simetría.



- Simetría
 - Red de 4 puertas
 - 1 plano de simetría
 - Puertas 1 y 4 indistinguibles
 - Puertas 2 y 3 indistinguibles



- Red de 4 puertas
- 2 planos de simetría
- Puertas 1 2,3 y 4 indistinguibles



$$S_{11} = S_{44} = S_{22} = S_{33}$$

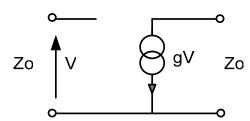
$$S_{12} = S_{43}$$
 $S_{21} = S_{34}$

$$S_{13} = S_{24}$$
 $S_{31} = S_{42}$

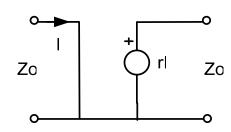
$$S_{14} = S_{23}$$
 $S_{41} = S_{32}$



- Simetría
- Si un cuadripolo es simétrico, entonces $S_{11} = S_{22}$ pero lo contrario no es cierto
 - Ejemplos



$$S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2gZo & 1 \end{bmatrix}$$



$$S = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ \frac{2r}{Zo} & -1 \end{bmatrix}$$

ACAF (2007-08)

II. Teoría Circuital de los dispositivos de RF.

27

ver. 0

J.R.M.G. J.A.R.C

3. Propiedades de la matriz S: reciprocidad, unitariedad, simetría.



- Otras matrices circuitales
 - Matriz Z

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ \dots \\ V_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} & \dots & Z_{1n} \\ Z_{21} & Z_{22} & \dots & Z_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ Z_{n1} & Z_{n2} & \dots & Z_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ \dots \\ i_n \end{bmatrix}$$

$$Z_{ji} = \frac{V_i}{i_i} \bigg|_{\substack{i_j = 0, \\ j \neq i}} \bullet \text{ Condición de circuito abierto}$$

Reciprocidad

$$z_{ij} = z_{ji}$$
 $[Z] = [Z]_{t}$

- - Pasiva y sin pérdidas

$$[Z]+[Z]_t^*=0$$



Otras matrices circuitales

$$\begin{bmatrix} \mathbf{i}_1 \\ \mathbf{i}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{i}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} & \dots & Y_{1n} \\ Y_{21} & Y_{22} & \dots & Y_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots \\ Y_{n1} & Y_{n2} & \dots & Y_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 \\ \mathbf{v}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{v}_n \end{bmatrix}$$

$$Y_{ji}=\frac{i_i}{V_i}\bigg|_{\begin{subarray}{c}V_j=0,\\\end{subarray}}$$

 • Condición de corto circuito • Admitancia de carga infinita

Reciprocidad

$$y_{ii} = y_{ii} \quad [Y] = [Y]_{t}$$

Pasiva y sin pérdidas

$$[Y] + [Y] = 0$$

ACAF (2007-08)

II. Teoría Circuital de los dispositivos de RF.

ver. 0

J.R.M.G. J.A.R.C

3. Propiedades de la matriz S: reciprocidad, unitariedad, simetría.



Cuadripolo genérico

$$[Z] = \begin{bmatrix} r_{11} + jx_{11} & r_{12} + jx_{12} \\ r_{21} + jx_{21} & r_{22} + jx_{22} \end{bmatrix}$$

8 variables reales

Cuadripolo recíproco

$$\begin{bmatrix} Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} + jx_{11} & r_{12} + jx_{12} \\ r_{12} + jx_{12} & r_{22} + jx_{22} \end{bmatrix}$$

6 variables reales

Cuadripolo sin pérdidas

$$\label{eq:Z} \left[Z \right] = \begin{bmatrix} jx_{11} & r_{12} + jx_{12} \\ -r_{12} + jx_{12} & jx_{22} \end{bmatrix} \qquad \text{4 variables reales}$$



Cuadripolo recíproco y sin pérdidas

$$\begin{bmatrix} \mathbf{Z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{j} \mathbf{x}_{11} & \mathbf{j} \mathbf{x}_{12} \\ \mathbf{j} \mathbf{x}_{12} & \mathbf{j} \mathbf{x}_{22} \end{bmatrix}$$

3 variables reales

Cuadripolo recíproco, sin pérdidas y simétrico

$$\begin{bmatrix} \mathbf{Z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{j} \mathbf{x}_{11} & \mathbf{j} \mathbf{x}_{12} \\ \mathbf{j} \mathbf{x}_{12} & \mathbf{j} \mathbf{x}_{11} \end{bmatrix}$$

2 variables reales

- De forma similar para el caso de parámetros Y
- Cuadripolo genérico

$$[Y] = \begin{bmatrix} g_{11} + jb_{11} & g_{12} + jb_{12} \\ g_{21} + jb_{21} & g_{22} + jb_{22} \end{bmatrix}$$

ACAF (2007-08)

II. Teoría Circuital de los dispositivos de RF.

31

ver. 0

J.R.M.G. J.A.R.C

Propiedades de la matriz S: reciprocidad, unitariedad, simetría.



Cuadripolo genérico

$$[S] = \begin{bmatrix} |s_{11}|e^{j\theta_{11}} & |s_{12}|e^{j\theta_{12}} \\ |s_{21}|e^{j\theta_{21}} & |s_{22}|e^{j\theta_{22}} \end{bmatrix}$$

8 variables reales

Cuadripolo recíproco

$$[S] = \begin{bmatrix} |s_{11}|e^{j\theta_{11}} & |s_{12}|e^{j\theta_{12}} \\ |s_{12}|e^{j\theta_{12}} & |s_{22}|e^{j\theta_{22}} \end{bmatrix}$$

6 variables reales

Cuadripolo sin pérdidas

$$[S] = \begin{bmatrix} |s_{11}|e^{j\theta_{11}} & \sqrt{1-|s_{11}|^2} e^{j\theta_{12}} \\ \sqrt{1-|s_{11}|^2} e^{j\theta_{21}} & |s_{11}|e^{j\theta_{22}} \end{bmatrix}$$
 4 variables reales

$$\theta_{21} = \theta_{11} + \theta_{22} - \theta_{12} \pm \pi (2n - 1)$$
 $n = 0,1,2,...$

ACAF (2007-08)

II. Teoría Circuital de los dispositivos de RF.



• Cuadripolo recíproco y sin pérdidas

$$[S] = \begin{bmatrix} |s_{11}|e^{j\theta_{11}} & \sqrt{1-|s_{11}|^2}e^{j\theta_{12}} \\ \sqrt{1-|s_{11}|^2}e^{j\theta_{12}} & |s_{11}|e^{j\theta_{22}} \end{bmatrix}$$
 3 variables reales
$$\theta_{12} = \frac{\theta_{11}+\theta_{22}}{2} + \frac{\pi}{2} \pm n\pi \quad n = 0,1,2,...$$

• Cuadripolo recíproco, sin pérdidas y simétrico

$$[S] = \begin{bmatrix} |s_{11}| e^{j\theta_{11}} & \sqrt{1 - |s_{11}|^2} e^{j\theta_{12}} \\ \sqrt{1 - |s_{11}|^2} e^{j\theta_{12}} & |s_{11}| e^{j\theta_{11}} \end{bmatrix}$$
 2 variables reales
$$\theta_{12} = \theta_{11} + \frac{\pi}{2} \pm n\pi \quad n = 0,1,2,...$$

ACAF (2007-08)

II. Teoría Circuital de los dispositivos de RF.

33

ver. 0

J.R.M.G, J.A.R.C

3. Propiedades de la matriz S: reciprocidad, unitariedad, simetría.



• Resumen

$$\begin{bmatrix} S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix}$$

- Sin pérdidas
- Sin pérdidas y recíproco
- Recíproco y simétrico

$$\begin{vmatrix} \mathbf{s}_{11} | = |\mathbf{s}_{22}| \\ |\mathbf{s}_{12}| = |\mathbf{s}_{21}| \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} \mathbf{s}_{11} | = |\mathbf{s}_{22}| \\ \mathbf{s}_{12} = \mathbf{s}_{21} \end{vmatrix}$$

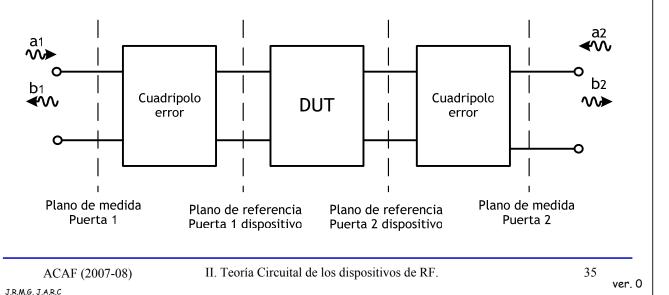
$$s_{12} = s_{21}$$

 $s_{11} = s_{22}$

4. Medida de parámetros S. Calibración



• En la caracterización de dispositivos de microondas mediante la medida de sus parámetros S, es necesario utilizar elementos auxiliares como conectores, cables y transiciones que no forman parte del dispositivo a medir DUT (Device Under Test). Mediante un proceso de calibrado se eliminan los efectos introducidos por dichos elementos auxiliares.



4. Medida de parámetros S. Calibración



Se considera que los dos cuadripolos error son iguales y además recíprocos.

- A partir de tres medidas es posible caracterizar el cuadripolo error y por lo tanto aislarlo de la medida del DUT
- Thru: conexión directa de las dos puertas de medida
- *Reflection*: en cada puerta de medida se conecta una carga cuyo valor no es necesario conocer a priori, siendo generalmente un cortocircuito
- *Line*: se conecta un tramo de línea de transmisión adaptada a las puertas de medida cuya longitud no es necesario conocer a priori
- De los resultados de estas tres medidas y mediante un algoritmo se calculan los parámetros S del cuadripolo error. Una vez conocido éste, al medir el DUT se compensará adecuadamente

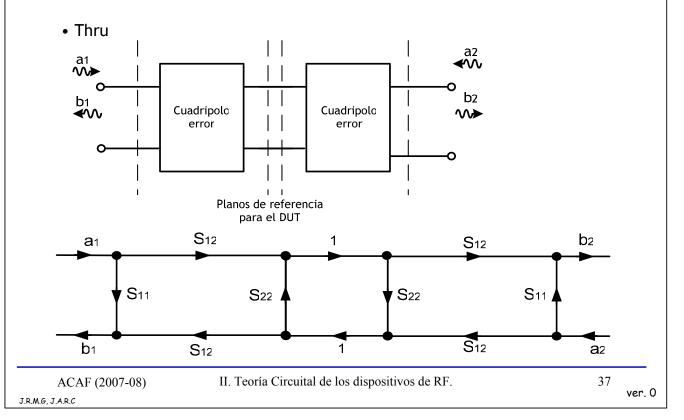
$$S = \begin{bmatrix} s_{11} & s_{12} \\ s_{12} & s_{22} \end{bmatrix}$$
 cuadripolo errror

ACAF (2007-08)

4. Medida de parámetros S. Calibración



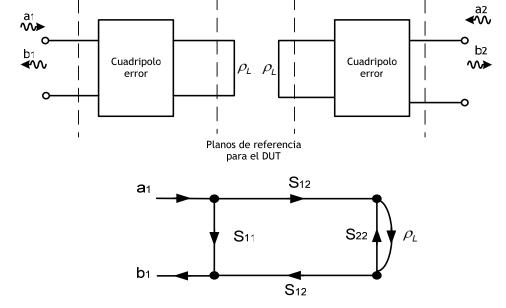
• Calibración TRL (Thru, Reflection, Line)



4. Medida de parámetros S. Calibración



- Calibración TRL (Thru, Reflection, Line)
 - Reflection



ACAF (2007-08)

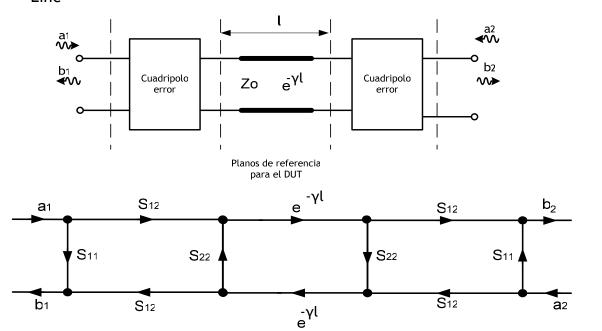
II. Teoría Circuital de los dispositivos de RF.

20

4. Medida de parámetros S. Calibración



- Calibración TRL (Thru, Reflection, Line)
 - Line



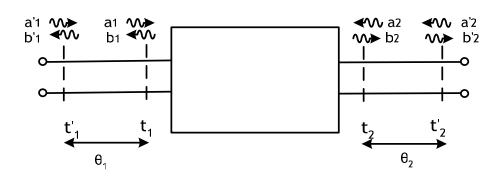
ACAF (2007-08) J.R.M.G, J.A.R.C

39 ver. 0

5. Desplazamiento de los planos de referencia



• Traslación hacia fuera del dispositivo de los planos de referencia



• En los planos t₁ y t₂

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_{11} & s_{12} \\ s_{21} & s_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$$

$$[b] = [S][a]$$

ACAF (2007-08)

5. Desplazamiento de los planos de referencia



• Relación entre las ondas de potencia en los planos t y t'

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{-j\theta_1} & 0 \\ 0 & e^{-j\theta_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a'_1 \\ a'_2 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} b'_1 \\ b'_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{-j\theta_1} & 0 \\ 0 & e^{-j\theta_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$
$$\begin{bmatrix} a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a' \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} b' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b \end{bmatrix}$$

• Operando

$$[b'] = [P][b] = [P][S][a] = [P][S][P][a']$$

 $[S'] = [P][S][P]$

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{S}_{11}^{'} & \boldsymbol{S}_{12}^{'} \\ \boldsymbol{S}_{21}^{'} & \boldsymbol{S}_{22}^{'} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{-j\theta_1} & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} & e^{-j\theta_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{S}_{11} & \boldsymbol{S}_{12} \\ \boldsymbol{S}_{21} & \boldsymbol{S}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-j\theta_1} & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} & e^{-j\theta_2} \end{bmatrix}$$

ACAF (2007-08)

II. Teoría Circuital de los dispositivos de RF.

4

ver. 0

J.R.M.G, J.A.R.C

5. Desplazamiento de los planos de referencia



• Matriz de traslación genérica P

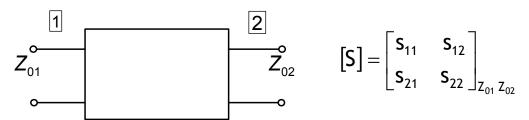
$$P = \begin{bmatrix} e^{-j\theta_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e^{-j\theta_2} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & e^{-j\theta_n} \end{bmatrix}$$

- Si la traslación es hacia el interior las exponenciales son positivas.
- La longitud eléctrica θ corresponde a la longitud física desplazada por la β del modo que se propaga θ = β l.
- \bullet En el caso de considerar pérdidas la β se sustituye por la γ

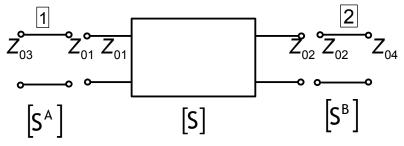
6. Cambio de la impedancia de referencia



• Supongamos un cuadripolo cuya matriz S se conoce, estando referenciada a $\rm Z_{01}$ en la puerta 1 y $\rm Z_{02}$ en la puerta 2.



• Se desea obtener la nueva matriz S, estando referenciada a Z_{03} en la puerta 1 y Z_{04} en la puerta 2.



ACAF (2007-08)

II. Teoría Circuital de los dispositivos de RF.

43

ver. 0

 $\mathsf{J.R.M.} \textit{G}, \, \mathsf{J.A.R.} \textit{C}$

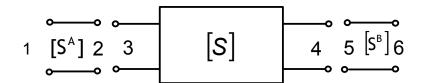
6. Cambio de la impedancia de referencia



$$[S^{A}] = \frac{1}{Z_{01} + Z_{03}} \begin{bmatrix} Z_{01} - Z_{03} & 2\sqrt{Z_{01}Z_{03}} \\ 2\sqrt{Z_{01}Z_{03}} & Z_{03} - Z_{01} \end{bmatrix}_{Z_{03} Z_{01}}$$

$$[S] = \begin{bmatrix} s_{11} & s_{12} \\ s_{21} & s_{22} \end{bmatrix}_{Z_{01} Z_{02}}$$

$$\left[S^{B} \right] = \frac{1}{Z_{02} + Z_{04}} \begin{bmatrix} Z_{04} - Z_{02} & 2\sqrt{Z_{02}Z_{04}} \\ 2\sqrt{Z_{02}Z_{04}} & Z_{04} - Z_{02} \end{bmatrix}_{Z_{02}Z_{04}}$$



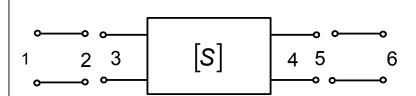
6. Cambio de la impedancia de referencia



$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_6 \\ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_{11}^A & 0 & s_{12}^A & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s_{22}^B & 0 & 0 & 0 & s_{21}^B \\ 0 & 0 & s_{22}^A & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & s_{11}^A & s_{12}^A & 0 \\ 0 & 0 & 0 & s_{21}^A & s_{22}^A & 0 \\ 0 & 0 & s_{12}^B & 0 & 0 & s_{11}^B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_6 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \\ a_5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} B_p \\ B_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{pp} & S_{pc} \\ S_{cp} & S_{cc} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_p \\ A_c \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{B}_{\mathsf{p}} \\ \mathbf{B}_{\mathsf{c}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{S}_{\mathsf{pp}} & \mathbf{S}_{\mathsf{pc}} \\ \mathbf{S}_{\mathsf{cp}} & \mathbf{S}_{\mathsf{cc}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{\mathsf{p}} \\ \mathbf{A}_{\mathsf{c}} \end{bmatrix}$$



- $\begin{vmatrix} b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{vmatrix}$
 - $[B_c] = [G][A_c]$

- p conexiones exteriores
- c conexiones interiores

ACAF (2007-08)

II. Teoría Circuital de los dispositivos de RF.

45

ver. 0

J.R.M.G. J.A.R.C

Cambio de la impedancia de referencia



$$\begin{bmatrix} B_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{cp} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_p \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} S_{cc} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_c \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} A_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G - S_{cc} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} S_{cp} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_p \end{bmatrix}$$

$$[B_p] = [S_{pp}] + [S_{pc}][G - S_{cc}]^{-1}[S_{cp}][A_p]$$

$$\left[\mathsf{S}_{p}\right] = \left[\mathsf{S}_{pp}\right] + \left[\mathsf{S}_{pc}\right]\left[\mathsf{G} - \mathsf{S}_{cc}\right]^{-1}\left[\mathsf{S}_{cp}\right]$$

7. Conexión en cascada de dos cuadripolos con parámetros S



$$\begin{bmatrix} \mathbb{S}^A \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} \mathbb{S}^B \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} \mathbb{S} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} S^{A} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_{11}^{A} & s_{12}^{A} \\ s_{21}^{A} & s_{22}^{A} \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} S^{B} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_{11}^{B} & s_{12}^{B} \\ s_{21}^{B} & s_{22}^{B} \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_{11}^{T} & s_{12}^{T} \\ s_{21}^{T} & s_{22}^{T} \end{bmatrix}$$

$$[S^{B}] = \begin{bmatrix} S_{11}^{B} & S_{12}^{B} \\ S_{21}^{B} & S_{22}^{B} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11}^\mathsf{T} & S_{12}^\mathsf{T} \\ S_{21}^\mathsf{T} & S_{22}^\mathsf{T} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_{11}^A + \frac{s_{12}^A s_{11}^B s_{21}^A}{1 - s_{11}^B s_{22}^A} & \frac{s_{12}^A s_{12}^B}{1 - s_{11}^B s_{22}^A} \\ \frac{s_{21}^A s_{21}^B}{1 - s_{11}^B s_{22}^A} & s_{22}^B + \frac{s_{12}^B s_{22}^A s_{21}^B}{1 - s_{11}^B s_{22}^A} \end{bmatrix}$$

ACAF (2007-08)

II. Teoría Circuital de los dispositivos de RF.

47

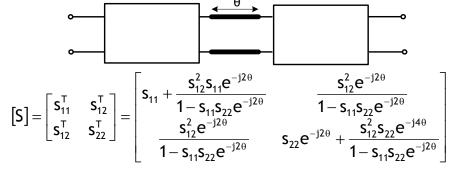
ver. 0

J.R.M.G. J.A.R.C

7. Conexión en cascada de dos cuadripolos con parámetros S



Conexión en cascada de 2 cuadripolos idénticos y recíprocos.



• Considerando niveles de adaptación elevados $|s_{11}|.|s_{22}| \approx 0$

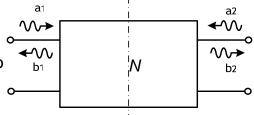
$$\left[S\right] \approx \begin{bmatrix} s_{11} + s_{12}^2 s_{11} e^{-j2\theta} & s_{12}^2 e^{-j2\theta} \\ s_{12}^2 e^{-j2\theta} & s_{22} e^{-j2\theta} + s_{12}^2 s_{22} e^{-j4\theta} \end{bmatrix}$$

• Para ciertos valores de frecuencia, el s_{11}^T es muy aproximadamente $2s_{11}$ y por lo tanto las nuevas pérdidas de retorno están 6 dB por debajo de las correspondientes al cuadripolo original

8. Teorema de Bartlett: simetría de los dispositivos pasivos



• Considerando un cuadripolo simétrico y recíproco.

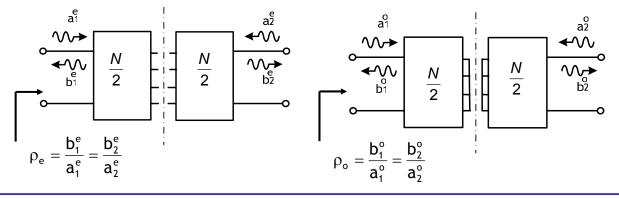


$$\begin{bmatrix}
b_1 \\
b_2
\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}
s_{11} & s_{21} \\
s_{21} & s_{11}
\end{bmatrix} \begin{bmatrix}
a_1 \\
a_2
\end{bmatrix}$$

• Excitación simétrica.

$$a_1^e = a_2^e = a$$

• Excitación asimétrica. $a_1^o = -a_2^o = a_1^o$



ACAF (2007-08)

II. Teoría Circuital de los dispositivos de RF.

y ver. 0

 $\mathsf{J.R.M.} \textit{G}, \, \mathsf{J.A.R.} \textit{C}$

8. Teorema de Bartlett: simetría de los dispositivos pasivos



• Suma de excitaciones y respuestas.

$$\begin{aligned} a_1 &= a_1^e + a_1^o = a + a = 2a \\ a_2 &= a_2^e + a_2^o = a - a = 0 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} b_1 &= b_1^e + b_1^o = \rho_e a_1^e + \rho_o a_1^o = (\rho_e + \rho_o) a = \frac{1}{2} (\rho_e + \rho_o) a_1 \\ b_2 &= b_2^e + b_2^o = \rho_e a_2^e + \rho_o a_2^o = (\rho_e - \rho_o) a = \frac{1}{2} (\rho_e - \rho_o) a_1 \end{aligned}$$

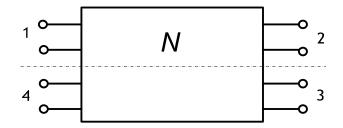
$$\begin{aligned} s_{11} &= \frac{b_1}{a_1} \bigg|_{a_2 = 0} = \frac{1}{2} (\rho_e + \rho_o) \\ s_{21} &= \frac{b_2}{a_1} \bigg|_{a_2 = 0} = \frac{1}{2} (\rho_e - \rho_o) \end{aligned} \qquad S = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \rho_e + \rho_o & \rho_e - \rho_o \\ \rho_e - \rho_o & \rho_e + \rho_o \end{bmatrix}$$

• En vez de resolver una vez una red de dos puertas para calcular s_{11} y s_{21} se resuelven dos redes de una puerta para calcular ρ_e y ρ_o

8. Teorema de Bartlett: simetría de los dispositivos pasivos



• Considerando una red de cuatro puertas recíproca y con un plano de simetría.



- Las puertas 1 y 4 son indistinguibles
- Las puertas 2 y 3 son indistinguibles

$$s_{11} = s_{44}$$
 $s_{22} = s_{33}$ $s_{21} = s_{34}$ $s_{31} = s_{24}$

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_{11} & s_{12} & s_{13} & s_{14} \\ s_{12} & s_{22} & s_{23} & s_{13} \\ s_{13} & s_{23} & s_{22} & s_{12} \\ s_{14} & s_{13} & s_{12} & s_{11} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{bmatrix}$$

ACAF (2007-08)

J.R.M.G, J.A.R.C

II. Teoría Circuital de los dispositivos de RF.

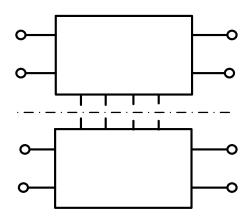
51

ver. 0

8. Teorema de Bartlett: simetría de los dispositivos pasivos

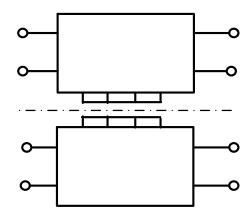


• Excitación simétrica.



$$S^{e} = \begin{bmatrix} s_{11}^{e} & s_{12}^{e} \\ s_{12}^{e} & s_{22}^{e} \end{bmatrix}$$

• Excitación asimétrica.



$$S^{\circ} = \begin{bmatrix} s_{11}^{\circ} & s_{12}^{\circ} \\ s_{12}^{\circ} & s_{22}^{\circ} \end{bmatrix}$$

8. Teorema de Bartlett: simetría de los dispositivos pasivos



• Aplicando ambas excitaciones se recompone la matriz

$$S = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} s_{11}^e + s_{11}^o & s_{12}^e + s_{12}^o & s_{12}^e - s_{12}^o & s_{11}^e - s_{11}^o \\ s_{12}^e + s_{12}^o & s_{22}^e + s_{22}^o & s_{22}^e - s_{22}^o & s_{12}^e - s_{12}^o \\ s_{12}^e - s_{12}^o & s_{22}^e - s_{22}^o & s_{22}^e + s_{22}^o & s_{12}^e + s_{12}^o \\ s_{11}^e - s_{11}^o & s_{12}^e - s_{12}^o & s_{12}^e + s_{12}^o & s_{11}^e + s_{11}^o \end{bmatrix}$$

• En vez de resolver una vez una red de cuatro puertas se resuelven dos veces, dos redes de dos puertas

ACAF (2007-08)

II. Teoría Circuital de los dispositivos de RF.

53

ver. 0

J.R.M.G, J.A.R.C

9. Relación entre parámetros S, Z, Y, ABCD



• Relación entre parámetros S y ABCD. Cuadriplo recíproco

$$s_{11} = \frac{AZ_0^{} + B - CZ_0^2^{2} - DZ_0^{}}{AZ_0^{} + B + CZ_0^2^{2} + DZ_0^{}} \quad \ s_{12}^{} = \frac{2Z_0^{}}{AZ_0^{} + B + CZ_0^2^{2} + DZ_0^{}}$$

$$s_{21} = \frac{2Z_0}{AZ_0 + B + CZ_0^2 + DZ_0} \quad s_{22} = \frac{-AZ_0 + B - CZ_0^2 + DZ_0}{AZ_0 + B + CZ_0^2 + DZ_0}$$

• Relaciones matriciales entre parámetros S y Z.

$$[Z] = \sqrt{[Zo]}[U - S]^{-1}[U + S]\sqrt{[Zo]}$$

$$[S_{\Omega}] = \sqrt{[Y_{\Omega}][Z - Z_{\Omega}][Z - Z_{\Omega}]^{-1}}\sqrt{[Y_{\Omega}]}$$

$$\left[{\rm Zo} \right] \quad {\rm ^{\bullet Matrices}\ diagonales\ que\ representan\ las} \atop {\rm impedancias\ de\ referencia\ en\ cada\ puerta}$$

 $\left[\mathsf{U} \right]$

Matriz unidad

9. Relación entre parámetros S, Z, Y, ABCD



 Considerando las matrices de impedancia y admitancia normalizadas

$$\left[\overline{Z}\right]\left[\overline{Y}\right]$$

$$\left[S\right] = \left[\overline{Z} - U\right] \left[\overline{Z} + U\right]^{\!\!-1} = \left[U\right] - 2 \left[\overline{Z} + U\right]^{\!\!-1}$$

$$\left[S\right] = \left[U - \overline{Y}\right] \left[U + \overline{Y}\right]^{\!\!-1} = 2 \! \left[U + \overline{Y}\right]^{\!\!-1} - \! \left[U\right]$$

$$[\overline{Z}] = [U + S][U - S]^{-1} = [U] + 2[S][U - S]^{-1}$$

$$\left[\overline{Y}\right] = \left[U - S\right] \left[U + S\right]^{-1} = \left[U\right] - 2 \left[S\right] \! \left[U + S\right]^{-1}$$

• Existen otras expresiones alternativas y por eso hay que tener en cuenta como realiza cada programa comercial estas transformaciones entre parámetros.

ACAF (2007-08)

II. Teoría Circuital de los dispositivos de RF.

55

ver. 0

J.R.M.G. J.A.R.C

10. Cálculo de los parámetros S de circuitos concentrados y distribuidos



Conexión directa con cambio de impedancia de referencia

$$Z_{01}$$
 Z_{0}

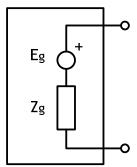
$$S = \begin{bmatrix} \frac{Z_{02} - Z_{01}}{Z_{02} + Z_{01}} & \frac{2\sqrt{Z_{01}Z_{02}}}{Z_{02} + Z_{01}} \\ \\ \frac{2\sqrt{Z_{01}Z_{02}}}{Z_{02} + Z_{01}} & \frac{Z_{01} - Z_{02}}{Z_{02} + Z_{01}} \end{bmatrix} \qquad S = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$Z_{01} = Z_{02} = Z_{0}$$

$$S = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$Z_{01} = Z_{02} = Z_0$$

• Generador real



$$b = \frac{Z_g - Z_0}{Z_g + Z_0} a + \frac{\sqrt{Z_0}}{Z_g + Z_0} \frac{E_g}{\sqrt{2}} \qquad b = Sa + c$$

$$|c|^2 = \frac{1}{8} \frac{|E_g|^2}{7_a} = P_{dg}$$

 $Z_g = Z_0$ $|c|^2 = \frac{1}{8} \frac{|E_g|^2}{Z_0} = P_{dg}$

ACAF (2007-08)

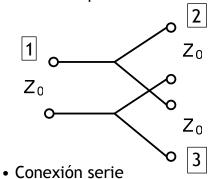
II. Teoría Circuital de los dispositivos de RF.

56

10. Cálculo de los parámetros S de circuitos concentrados y distribuidos



Conexión paralelo



$$S = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$S = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

ACAF (2007-08)

II. Teoría Circuital de los dispositivos de RF.

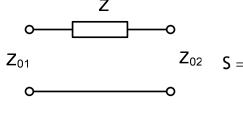
57 ver. 0

J.R.M.G. J.A.R.C

Cálculo de los parámetros S de circuitos concentrados y distribuidos



• Impedancia serie



$$S = \begin{bmatrix} \frac{Z}{Z + 2Z_0} & \frac{2Z_0}{Z + 2Z_0} \\ \\ \frac{2Z_0}{Z + 2Z_0} & \frac{Z}{Z + 2Z_0} \end{bmatrix}$$

Admitancia paralelo

$$Z_{01} = Z_{02} = Z_0$$

$$Z_{01}$$
 Y Z_{0}

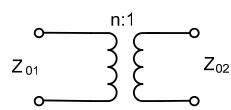
$$\begin{array}{c} \textbf{Z}_{02} \quad \textbf{S} = \begin{bmatrix} \frac{Z_{02} - Z_{01} - YZ_{01}Z_{02}}{Z_{02} + Z_{01} + YZ_{01}Z_{02}} & \frac{2\sqrt{Z_{01}Z_{02}}}{Z_{02} + Z_{01} + YZ_{01}Z_{02}} \\ \\ \frac{2\sqrt{Z_{01}Z_{02}}}{Z_{02} + Z_{01} + YZ_{01}Z_{02}} & \frac{Z_{01} - Z_{02} - YZ_{01}Z_{02}}{Z_{02} + Z_{01} + YZ_{01}Z_{02}} \end{bmatrix} \\ \textbf{S} = \begin{bmatrix} \frac{-Y}{Y + 2Y_{0}} & \frac{2Y_{0}}{Y + 2Y_{0}} \\ \\ \frac{2Y_{0}}{Y + 2Y_{0}} & \frac{-Y}{Y + 2Y_{0}} \end{bmatrix}$$

$$S = \begin{bmatrix} \frac{-Y}{Y + 2Y_0} & \frac{2Y_0}{Y + 2Y_0} \\ \\ \frac{2Y_0}{Y + 2Y_0} & \frac{-Y}{Y + 2Y_0} \end{bmatrix}$$

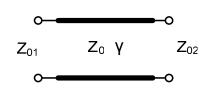
$$Z_{01} = Z_{02} = Z_0 = \frac{1}{Y_0}$$

10. Cálculo de los parámetros S de circuitos concentrados y distribuidos





$$S = \begin{bmatrix} \frac{n^2 Z_{02} - Z_{01}}{n^2 Z_{02} + Z_{01}} & \frac{2n \sqrt{Z_{01}} Z_{02}}{n^2 Z_{02} + Z_{01}} \\ Z_{02} & S = \begin{bmatrix} \frac{n^2 - 1}{n^2 Z_{02} + Z_{01}} & \frac{2n \sqrt{Z_{01}} Z_{02}}{n^2 Z_{02} + Z_{01}} \\ \frac{2n \sqrt{Z_{01}} Z_{02}}{n^2 Z_{02} + Z_{01}} & \frac{Z_{01} - n^2 Z_{02}}{n^2 Z_{02} + Z_{01}} \end{bmatrix} \quad S = \begin{bmatrix} \frac{n^2 - 1}{n^2 + 1} & \frac{2n}{n^2 + 1} \\ \frac{2n}{n^2 + 1} & \frac{1 - n^2}{n^2 + 1} \end{bmatrix}$$



$$Z_{0} \quad \gamma \qquad Z_{02} \qquad S = \begin{bmatrix} \frac{\left(Z_{0}^{2} - Z_{01}Z_{02}\right)\tanh(\gamma l) + Z_{0}\left(Z_{02} - Z_{01}\right)}{\left(Z_{0}^{2} + Z_{01}Z_{02}\right)\tanh(\gamma l) + Z_{0}\left(Z_{01} + Z_{02}\right)} & \frac{2Z_{0}\sqrt{Z_{01}Z_{02}}}{\cosh(\gamma l)} \\ \frac{\left(Z_{0}^{2} + Z_{01}Z_{02}\right)\tanh(\gamma l) + Z_{0}\left(Z_{01} + Z_{02}\right)}{\left(Z_{0}^{2} + Z_{01}Z_{02}\right)\tanh(\gamma l) + Z_{0}\left(Z_{01} + Z_{02}\right)} & \frac{2Z_{0}\sqrt{Z_{01}Z_{02}}}{\left(Z_{0}^{2} + Z_{01}Z_{02}\right)\tanh(\gamma l) + Z_{0}\left(Z_{01} - Z_{02}\right)} \\ \frac{2Z_{0}\sqrt{Z_{01}Z_{02}}}{\cosh(\gamma l)} & \frac{\left(Z_{0}^{2} - Z_{01}Z_{02}\right)\tanh(\gamma l) + Z_{0}\left(Z_{01} - Z_{02}\right)}{\left(Z_{0}^{2} + Z_{01}Z_{02}\right)\tanh(\gamma l) + Z_{0}\left(Z_{01} + Z_{02}\right)} \end{bmatrix}$$

$$Z_{01} = Z_{02} = Z_0 = \frac{1}{Y_0} \qquad S = \begin{bmatrix} 0 & e^{-\gamma l} \\ e^{-\gamma l} & 0 \end{bmatrix}$$

ACAF (2007-08)

J.R.M.G. J.A.R.C

II. Teoría Circuital de los dispositivos de RF.

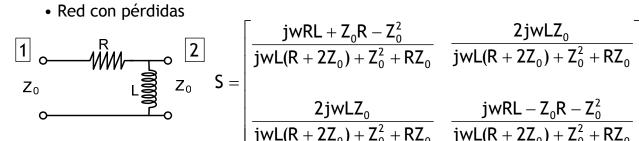
 $Z_{01} = Z_{02} = Z_0$

ver. 0

Cálculo de los parámetros S de circuitos concentrados y distribuidos



Red con pérdidas



$$\frac{2jwLZ_0}{jwL(R+2Z_0)+Z_0^2+RZ_0}$$

$$\frac{2jwLZ_0}{jwL(R+2Z_0)+Z_0^2+RZ_0}$$

$$\frac{jwRL - Z_0R - Z_0^2}{jwL(R + 2Z_0) + Z_0^2 + RZ_0}$$

Existe reciprocidad

No existe simetría

Existen pérdidas

$$s_{12} = s_{21}$$

$$S_{11} \neq S_{22}$$

$$\left|\mathbf{S}_{11}\right| \neq \left|\mathbf{S}_{22}\right|$$

10. Cálculo de los parámetros S de circuitos concentrados y distribuidos



• Potencia disipada en R excitando en la puerta 1 con un generador Vg,Zo y la 2 cargada con Zo

$$P_{R}^{1} = \frac{1}{2} \frac{\left|V_{g}\right|^{2} (Z_{0}^{2} + w^{2}L^{2})R}{\left(RZ_{0} + Z_{0}^{2}\right)^{2} + \left(wLR + 2wLRZ_{0}\right)^{2}}$$

• Potencia disipada en R excitando en la puerta 2 con un generador Vg, Zo y la 1 cargada con Zo

$$P_{R}^{2} = \frac{1}{2} \frac{\left|V_{g}\right|^{2} (w^{2}L^{2})R}{\left(RZ_{0} + Z_{0}^{2}\right)^{2} + \left(wLR + 2wLRZ_{0}\right)^{2}}$$

$$P_{R}^{1} \neq P_{R}^{2}$$

ACAF (2007-08)

II. Teoría Circuital de los dispositivos de RF.

61

ver. 0

J.R.M.G. J.A.R.C

Análisis por ordenador de dispositivos caracterizados por matriz S



- Existen diferentes técnicas para calcular los parámetros S de redes multipuerta conectadas arbitrariamente.

ACAF (2007-08)

II. Teoría Circuital de los dispositivos de RF.

62

ver. 0

11. Análisis por ordenador de dispositivos caracterizados por matriz S



• Matriz S global

• Matriz de la geometría

$$[b] = [G][a]$$

ACAF (2007-08)

J.R.M.G. J.A.R.C

II. Teoría Circuital de los dispositivos de RF.

63

ver. 0

11. Análisis por ordenador de dispositivos caracterizados por matriz S



$$\begin{bmatrix} b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} G - S \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c \end{bmatrix}$$

$$[a] = [G - S]^{-1}[c]$$

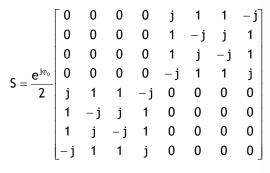
$$S_{11} = \frac{b_1}{a_1}\Big|_{a_4=0} = \frac{a_8}{b_8} = \frac{a_8}{c_8} = a_8$$

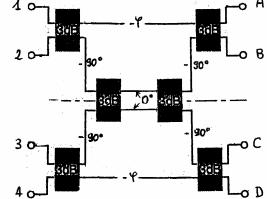
$$S_{21} = \frac{b_4}{a_1}\Big|_{a_1=0} = \frac{a_7}{b_8} = \frac{a_7}{c_8} = a_7$$

11. Análisis por ordenador de dispositivos caracterizados por matriz S



• Ejemplo: Matriz de Butler del satélite GAIA





Especificaciones

- Banda de trabajo: 8430 8520 MHz
- Adaptación > 25 dB
- Aislamiento > 25 dB
- Desbalance de amplitud en la banda de paso: 0.3 dB
- Desbalance de fase respecto del ideal en la banda de paso: +/- 2.5°

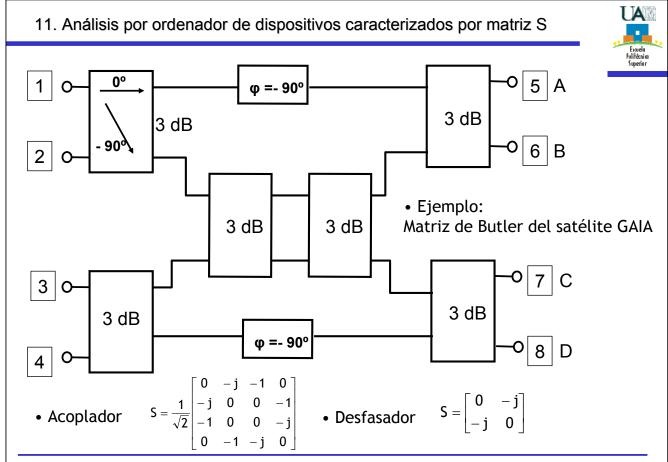
ACAF (2007-08)

II. Teoría Circuital de los dispositivos de RF.

65

ver. 0

J.R.M.G, J.A.R.C



ACAF (2007-08)

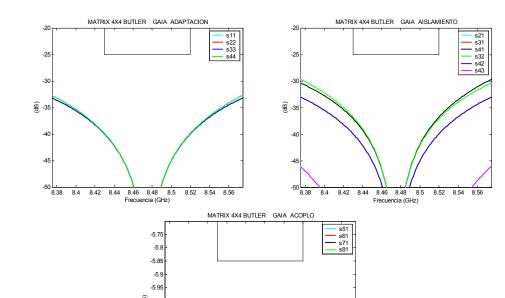
II. Teoría Circuital de los dispositivos de RF.

66

ver. 0

11. Análisis por ordenador de dispositivos caracterizados por matriz S





Matriz de Butler del satélite GAIA

• Ejemplo:

ACAF (2007-08) J.R.M.G, J.A.R.C II. Teoría Circuital de los dispositivos de RF.

67

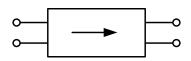
ver. 0

12. Dispositivos de 2,3 y 4 puertas



Aislador

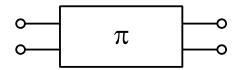
Dispositivo adaptado, no recíproco, con pérdidas



$$S = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Girador

Dispositivo adaptado, no recíproco, sin pérdidas



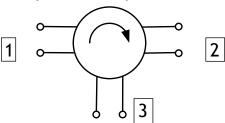
$$S = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

12. Dispositivos de 2,3 y 4 puertas



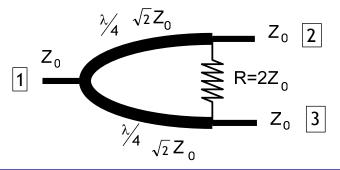
Circulador

Dispositivo adaptado, no recíproco, sin pérdidas



$$S = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

Divisor Wilkinson
 Dispositivo adaptado, recíproco, con pérdidas y 1 plano de simetría



$$S = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & -j & -j \\ -j & 0 & 0 \\ -j & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ACAF (2007-08)

J.R.M.G. J.A.R.C

II. Teoría Circuital de los dispositivos de RF.

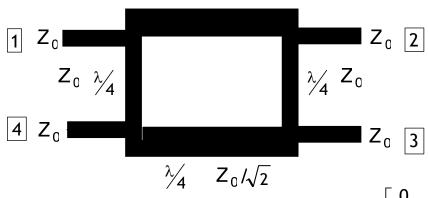
69

ver. 0

12. Dispositivos de 2,3 y 4 puertas



• Acoplador branch-line 3 db y 90° Dispositivo adaptado, recíproco, sin pérdidas y 2 planos de simetría $\frac{\lambda}{4}$ $Z_0/\sqrt{2}$

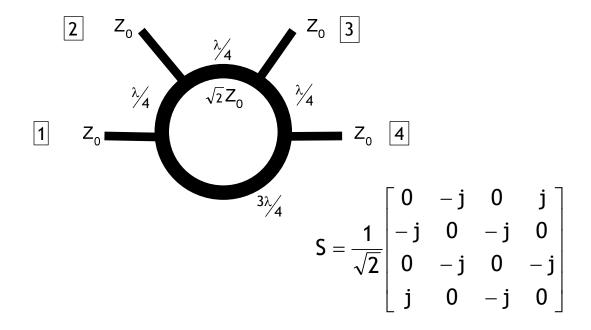


$$S = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & -j & -1 & 0 \\ -j & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & -j \\ 0 & -1 & -j & 0 \end{bmatrix}$$

12. Dispositivos de 2,3 y 4 puertas



Acoplador rat-race 3 db y 180°
 Dispositivo adaptado, recíproco, sin pérdidas y 1 plano de simetría



ACAF (2007-08)

J.R.M.G, J.A.R.C

II. Teoría Circuital de los dispositivos de RF.

71

ver. 0